

2023 年度 第 3 回半導体エレクトロニクス部門委員会第 2 回研究会
2023 年度 第 3 回ナノ材料部門委員会 第 3 回研究会

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
日本材料学会ナノ材料部門委員会
期 日： 2023 年 11 月 25 日（土） 13：00 ～ 17：00（予定）
13:00 ～ 13:30：招待講演(30 分)
13:30 ～ 17:00：一般講演（口頭講演、質疑応答込 1 件 20 分）
会 場： 立命館大学 朱雀キャンパス 1F 多目的室 2 (JR 二条駅から徒歩 2 分)
一般参加費： 無料

半導体エレクトロニクス部門委員会およびナノ材料部門委員会合同の研究会を、上記のとおり開催いたしますので、研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

■半導体エレクトロニクス部門委員会の賞

本研究会における優れた発表に対して半導体エレクトロニクス部門委員会から下記の賞を授与します。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

学生優秀講演賞：博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

講演奨励賞：若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定 (https://algainn.jsms.jp/?page_id=48)」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿を投稿してください。

<講演申込内容>

- ・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

<講演原稿作成要領>

- ・A4 サイズ 1-4 枚以内（図、表、写真を含む）、日本語または英語
- ・1 枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdf ファイルにて投稿

■講演申込期日： 11 月 10 日（金）、講演原稿送付期日： 11 月 17 日（金）

■講演プログラム

プログラムは 11 月中旬に公開予定です。

<招待講演> 金子 光顕 助教 京都大学

「SiC JFET を用いた厳環境動作相補型論理回路」

近年、高温・放射線暴露といった厳環境で動作可能な集積回路に注目が集まっている。ワイドギャップ半導体はシリコンの材料限界を打破する半導体として注目を集めており、集積回路分野においても例外ではない。中でも、炭化ケイ素（SiC）はイオン注入により広範囲の p、n 型の伝導型制御が可能のため、厳環境動作集積回路に適した材料として期待されている。本発表では、SiC JFET を用いた相補型回路の概要とその作製について紹介する。

■意見交換会(17:30～)

二条駅周辺で行います。参加される方は研究室単位で参加人数を金子までお知らせください。

■問合せ先

- ・半導体エレクトロニクス部門、講演プログラムおよび原稿に関する問い合わせ

金子 健太郎(立命館大学) E-mail: ken0710[a t]fc.ritsumei.ac.jp

- ・ナノ材料部門に関する問い合わせ

田中 勝久(京都大学) E-mail: tanaka.katsuhisa.4n[a t]kyoto-u.ac.jp
[a t]は@に置き換えてください。